



日本国特許庁  
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて  
いる事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed  
with this Office

出願年月日  
Date of Application:

2000年11月 2日

出願番号  
Application Number:

特願2000-336091

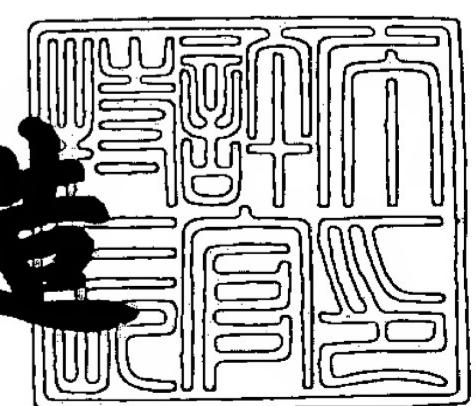
出願人  
Applicant(s):

株式会社ニコン  
株式会社荏原製作所

2001年 8月10日

特許庁長官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

及川耕造



出証番号 出証特2001-3070860

【書類名】 特許願  
【整理番号】 001527  
【提出日】 平成12年11月 2日  
【あて先】 特許庁長官 殿  
【国際特許分類】 G01N  
【発明者】  
【住所又は居所】 東京都大田区羽田旭町11番1号 荘原マイスター株式会社内  
【氏名】 中筋 譲  
【発明者】  
【住所又は居所】 東京都大田区羽田旭町11番1号 株式会社莊原製作所内  
【氏名】 佐竹 徹  
【発明者】  
【住所又は居所】 東京都大田区羽田旭町11番1号 株式会社莊原製作所内  
【氏名】 野路 伸治  
【特許出願人】  
【識別番号】 000004112  
【氏名又は名称】 株式会社ニコン  
【特許出願人】  
【識別番号】 000000239  
【氏名又は名称】 株式会社莊原製作所  
【代理人】  
【識別番号】 100089705  
【住所又は居所】 東京都千代田区大手町二丁目2番1号 新大手町ビル2  
06区 ユアサハラ法律特許事務所  
【弁理士】  
【氏名又は名称】 社本 一夫

【電話番号】 03-3270-6641

【選任した代理人】

【識別番号】 100080137

【弁理士】

【氏名又は名称】 千葉 昭男

【選任した代理人】

【識別番号】 100083895

【弁理士】

【氏名又は名称】 伊藤 茂

【選任した代理人】

【識別番号】 100093713

【弁理士】

【氏名又は名称】 神田 藤博

【選任した代理人】

【識別番号】 100093805

【弁理士】

【氏名又は名称】 内田 博

【選任した代理人】

【識別番号】 100106208

【弁理士】

【氏名又は名称】 宮前 徹

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 051806

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 0010958

特2000-336091

【ブルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 電子線装置及びその電子線装置を用いたデバイスの製造方法

【特許請求の範囲】

【請求項1】 電子線を放出する单一の電子銃、複数の孔を設けた開口板、複数のレンズ及び相互に離隔して配置された少なくとも二つのE×B分離器を有していて前記電子銃からの電子線を検査されるべき試料面上に照射する第一次光学系と、前記試料から放出された二次電子を、前記E×B分離器の内の一つで第一次光学系から分離し、二次電子検出装置に入射させて検出する第二次光学系とを備え、

前記電子銃からの電子線を前記開口板に照射して複数の孔の像を形成し、前記複数の孔の像の位置を前記E×B分離器のそれぞれの位置に一致させ、かつ前記それぞれのE×B分離器の電界で偏向される電子線の方向が試料面上で見て相互に逆方向となるようにしたことを特徴とする電子線装置。

【請求項2】 請求項1に記載の電子線装置において、前記第一次光学系及び第二次光学系は、前記E×B分離器の内の一つによって偏向された二次電子の経路が互いに干渉しないように、2行複数列の組に配置されていることを特徴とする電子線装置。

【請求項3】 電子線を放出する单一の電子銃、複数の孔を設けた開口板、複数のレンズ及びE×B分離器を有していて前記電子銃からの電子線を検査されるべき試料面上に照射する第一次光学系と、前記試料から放出された二次電子を、前記E×B分離器で第一次光学系から分離し、二次電子検出装置に入射させて検出する第二次光学系とを備え、

前記電子銃からの電子線を前記開口板に照射して複数の孔の像を形成し、前記複数の孔の像の位置を前記E×B分離器の位置に一致させ、かつ前記E×B分離器の電界に走査電圧を重畠させて、前記電子線の偏向動作をさせることを特徴とする電子線装置。

【請求項4】 請求項1又は3に記載の電子線装置において、前記第一次光学系及び第二次光学系は、前記E×B分離器によって偏向された二次電子の経路が互いに干渉しないように、2行複数列の組に配置されていることを特徴とする

電子線装置。

【請求項5】 請求項1ないし4のいずれかに記載の電子線装置を用いてプロセス途中のウエハーの評価を行うことを特徴とするデバイスの製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】

本発明は電子線装置及びその電子線装置を用いたデバイスの製造方法に関し、詳しくは、最小線幅が0.1μm以下のデバイスパターンを有する試料の欠陥検査、線幅測定、合わせ精度測定、表面電位測定又は高精度時間分解能測定を高いスループットでかつ高い信頼性で行える電子線装置並びにその電子線装置を用いてプロセス途中のウエハーを評価することにより歩留まり率を向上させることができるデバイスの製造方法に関する。

【0002】

【従来技術】

最小線幅が0.1μm以下のデバイスパターンを有する試料の欠陥検査等を行う場合、光方式では光の回折により解像度から見て限界にきており、そのため、電子線を利用した検査・評価装置が提案されている。電子線を用いると解像度は向上するがスループットが極端に小さくなるため生産性の観点から問題がある。生産性を向上させるべくマルチビームを用いた電子線装置、即ち、単一の電子銃から放出した電子線を複数の開口に照射し、それらの開口を通過した電子ビームで試料の表面（以下試料面と呼ぶ）を走査し、各像からたたた二次電子を複数の検出器に導いて試料を検査する電子線装置は既に公知である。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、公知の技術では、二次電子を複数の検出器で検出する具体的方法が明確でなく、高い分解能で試料を検査・評価することが可能であるか否かについても明確でない。また、一次光学系における電子ビームを試料面に対して斜め方向から照射しており、静電対物レンズと試料間が軸対象の構造ではないため、電子ビームを細く絞れない等の問題がある。

更に、試料からの二次電子をE×B分離器により分離してそれを検出器に導く技術も既に公知であるが、この場合、E×B分離器の電界で偏向される電子ビームの偏向量及び偏向方向が低エネルギーの電子ビームと高エネルギーの電子ビームとで相違するため、色収差が生じるという問題がある。また、E×B分離器を設けた場合、検査試料の付近に偏向器を配置するためのスペースを確保することが困難である、という問題もある。

## 【0004】

本発明が解決しようとする一つの課題は、写像投影型光学系の電子線装置にE×B分離器を備え、複数の電子ビームを用いて試料の検査を行うことにより、試料検査・評価等を高いスループットでしかも高い信頼性で行うことができる具体的な電子線装置を提供することである。

本発明が解決しようとする他の課題は、電子ビームを細く絞るようにした電子線装置を提供することである。

本発明が解決しようとする別の課題は、E×B分離器を使用することにより生じる色収差を補正することができる電子線装置を提供することである。

本発明が解決しようとする更に別の課題は、電子線装置の光学系を2行複数列に配置して、試料の検査・評価等を高いスループットでしかも高い信頼性で行うことができる装置を提供することである。

本発明が解決しようとする更に別の課題は、E×B分離器と偏向器とを兼用することにより、E×B分離器と偏向器の両者と共に最適の位置に配置することができる電子線装置を提供することである。

本発明が解決しようとする更に別の課題は、上記のような電子線装置を用いてプロセス途中の試料を評価するデバイスの製造方法を提供することである。

## 【0005】

## 【課題を解決するための手段】

上記課題は以下の手段により解決される。即ち、本願の発明の一つは、電子線を放出する单一の電子銃、複数の孔を設けた開口板、複数のレンズ及び相互に離隔して配置された少なくとも二つのE×B分離器を有していて前記電子銃からの電子線を検査されるべき試料面上に照射する第一次光学系と、前記試料から放出

された二次電子を、前記E×B分離器の内の一つで第一次光学系から分離し、二次電子検出装置に入射させて検出する第二次光学系とを備え、前記電子銃からの電子線を前記開口板に照射して複数の孔の像を形成し、前記複数の孔の像の位置を前記E×B分離器のそれぞれの位置に一致させ、かつ前記それぞれのE×B分離器の電界で偏向される電子線の方向が試料面上で見て相互に逆方向となるようにしている。このように構成したことにより、複数の電子線を用いて試料の検査・評価等を高いスループットでしかも高い信頼性で行うことができる。また、E×B分離器により生じる色収差を補正することが可能となり、更に電子ビームを細く絞ることも可能となったため、高い検査精度を確保することができる。

また、電子線装置の発明の別の態様において、前記E×B分離器の電界で偏向される電子線の偏向量が試料面上で見て相互に逆方向でありかつその絶対値が等しいように構成してもよい。

上記のような電子線装置を、E×B分離器によって偏向された二次電子の経路が互いに干渉しないように、2行複数列に配置してもよい。それにより、試料の検査・評価等を高いスループットでしかも高い信頼性で行うことができる。

#### 【0006】

本願の別の発明では、電子線を放出する单一の電子銃、複数の孔を設けた開口板、複数のレンズ及びE×B分離器を有していて前記電子銃からの電子線を検査されるべき試料面上に照射する第一次光学系と、前記試料から放出された二次電子を、前記E×B分離器で第一次光学系から分離し、二次電子検出装置に入射させて検出する第二次光学系とを備え、前記電子銃からの電子線を前記開口板に照射して複数の孔の像を形成し、前記複数の孔の像の位置を前記E×B分離器の位置に一致させ、かつ前記E×B分離器の電界に走査電圧を重畠させて、前記電子線の偏向動作をさせるようにしている。このように構成したことにより、E×B分離器と偏向器とを兼用させて、両者を最適の位置に配置することができる。

#### 【0007】

前記一つの発明及び別の発明による電子線装置において、前記電子線装置は、欠陥検査装置、線幅測定装置、欠陥レビュー装置、EBテスター装置及び電位コントラスト測定装置のいずれかであってもよい。

## 【0008】

本願の更に別の発明は、前記電子線装置を用いてプロセス途中のウエハーの評価を行ってデバイスの製造を行うことである。

## 【0009】

## 【発明の実施の形態】

以下図面を参照して本発明による電子線装置の実施形態を説明する。

図1において、本実施形態の電子線装置1が模式的に示されている。この電子線装置1は、第一次光学系10と、第二次光学系30と、検出装置40とを備えている。第一次光学系10は、電子線を試料Sの表面（試料面）に照射する光学系で、電子線を放出する電子銃11と、電子銃から放出された電子線を偏向する静電レンズ12と、二次元的に配列された複数の小孔（ただし、図1では13aないし13eのみ図示する）が形成された開口板13と、静電偏向器14と、開口アパーチャ15と、開口板を通過した電子ビームを偏向する静電中間レンズ16と、第一のE×B分離器17と、電子ビームを偏向する静電中間レンズ18と、静電偏向器19と、第二のE×B分離器20と、静電対物レンズ21と静電偏向器22とを備え、それらは、図1に示すように電子銃11を最上部にして順に、かつ電子銃から放出される電子線の光軸Aが試料の表面SFに垂直になるよう配置されている。従って、静電対物レンズ21と試料S間を軸対象の構造とすることができ、電子ビームを細く絞ることができる。

第二次光学系30は、第一次光学系10の第二のE×B分離器20の近くで光軸Aに対して傾斜している光軸Bに沿って配置された静電拡大レンズ31と、二次元的に配列された複数の小孔（図では32aないし32eのみ図示する）が形成された開口板32とを備えている。検出装置40は開口板32の各開口毎に検出器41を備えている。なお、開口板32の開口（32aないし32e）の数は第一次光学系の開口板13に形成される小孔（13aないし13e）の数及び配列に合わせた数及び配列となっている。

上記各構成要素は公知のものであってもよく、それらの構造の詳細説明は省略する。

## 【0010】

次に上記構成の電子線装置1の動作について説明する。

単一の電子銃11から放出された電子線Cは静電レンズ12で収束され、開口板13を照射する。電子線Cは開口板13に形成された複数の小孔(13aないし13e)を通過して複数の電子ビームにされる。これら複数の電子ビームは開口部を有する開口アーチャ15でクロスオーバーC1を形成する。クロスオーバーした電子ビームは試料Sに向かって進み、途中に設けられた静電中間レンズ16及び静電中間レンズ18により収束され、静電対物レンズ21の正面に結像されて、カラー照明条件を満足する。一方、開口板13の各小孔の像を形成する電子ビームDは静電中間レンズ16により収束されて第一のE×B分離器17の偏向正面FP1に結像し、更に静電中間レンズ18により収束されて第二のE×B分離器20の偏向正面FP2に結像し、最終的に試料面SFに結像する。

#### 【0011】

試料面SFから放出された二次電子は、静電対物レンズ21と試料面SFとの間に印加された、二次電子に対する加速電界で加速、収束され、静電対物レンズ21を通過し、第二のE×B分離器20の偏向正面FP2の少し手前でクロスオーバーを結像する。この結像した二次電子は第二のE×B分離器20により光軸Bに沿って移動するように偏向されて静電拡大レンズ31に入射する。二次電子は次に静電拡大レンズ31により拡大され、開口板32の小孔(32aないし32e)において拡大結像される。試料面SFと開口板32は二次電子強度の2eVの値に対して光学的共役関係にあり、開口板13の小孔13aを通った電子ビームにより試料面SFで放出された二次電子は開口板32の小孔32aを通して、小孔13bを通った電子ビームにより試料面SFで放出された二次電子は開口板32の小孔32bを通して、小孔13cを通った電子ビームにより試料面SFで放出された二次電子は開口板32の小孔32cを通して、と言ったように、電子ビームにより試料面で放出された二次電子は開口板13の各小孔に対応する開口板32の各小孔を通って検出器41に入射する。

#### 【0012】

上記複数の電子ビームとそれに隣接する電子ビームの間は、静電偏向器19と第二のE×B分離器20とを用いて符号Eで示されている主光線軌道になるよう

に電子ビームを偏向走査して、各電子ビームの間の走査を行うことができる。第二のE×B分離器で偏向走査を行うには、第二のE×B分離器20のウィーンフィルター条件を満足し、電子ビームを直進させる電圧をVw、磁場をBwとすると、Vwの直流電圧を中心にしてその電圧に走査電圧が重畠するような電圧波形を与えることによく、第二のE×B分離器20の電界を与える電極を8極の静電偏向器とすると二次元の走査が可能となる。従って、静電対物レンズ21の上部に偏向器を新たに設ける必要がなく、しかもE×B分離器も静電偏向器も最適の位置に配置することができる。

### 【0013】

次に、従来技術において単一のE×B分離器を使用することにより色収差が生じていわゆるビームボケが生じる問題点と、その解決策について説明する。

一般的に、E×B分離器を使用する電子線装置においては、電子ビームに対して開口の像の位置とE×B分離器の偏向主面とが一致した時に収差が最も小さい。しかもE×B分離器の偏向主面と試料面は共役になっている。そのため、エネルギー幅のある電子ビームがE×B分離器に入射したとき、低いエネルギーの電子ビームが電界により偏向される量はエネルギーに逆比例して大きくなるが、磁場により偏向される量はエネルギーの $1/2$ 乗に逆比例してしか大きくならない。一方、高いエネルギーの電子ビームの場合は、電界により偏向される方向に電子ビームが偏向される量よりも磁場により偏向される方向に偏向される量の方が大きくなる。この場合、E×B分離器の下側に静電レンズが設けられかつそのレンズが無収差であればビームボケは生じないが、現実的にはレンズに収差があるためビームボケが生じる。従って、単一のE×B分離器を使用するのみでは電子ビームのエネルギーに幅がある場合には色収差によりビームボケが生じることは回避できない。

本発明では、第一と第二の二つのE×B分離器17及び20を備え、第一のE×B分離器17と第二のE×B分離器20との電界による偏向方向が試料面上で見て相互に逆方向になり、かつ偏向の大きさの絶対値が等しくなるように、各E×B分離器の電界を調整している。従って、電子ビームのエネルギーに幅がある場合でも、E×B分離器による色収差は、第一及び第二のE×B分離器17及び20

により相互に相殺される。

#### 【0014】

上記構成の電子線装置1を使用して試料面の欠陥検査、試料面に形成されたパターンの線幅の測定等を行うには、検査すべき試料をセットし、電子線装置1を上述のように動作させる。この場合、静電偏向器19及び第二のE×B分離器20に与える走査信号波形と、二次電子の検出器41の出力信号とで画像データを作成し、その画像データと、別途得られたパターンデータから作成した画像データとを比較することにより欠陥検査を行うことができる。また、静電偏向器19及び第二のE×B分離器20により、測定したパターンをその直角方向に走査し、そのとき得られた二次電子の信号波形からパターンの線幅の測定が行える。更に、一層目のリソグラフィで形成されるパターンの近傍に二層目のリソグラフィで形成されるパターンを形成し、これら二本のパターンを電子線装置1の複数の電子ビームのビーム間隔と略等しい間隔で形成しておき、これら二本のパターン間隔を測定し、その測定値を設計値と比較することにより、合わせ精度を評価することができる。

また、二次電子の検出器41の一部又は全部にCRTモニターを接続し、走査信号波形と共に入力することにより走査型電子顕微鏡(SEM)像をCRTモニター上に形成することができる。検査人はこのSEM像を見ながら欠陥の種類等を観察できる。

#### 【0015】

図1において、静電対物レンズ21と試料面SFとの間に同軸状に静電偏向器22を設け、この静電偏向器22に負の電圧を与えることにより電位コントラストを測定することができる。

また、図1において、電子ビームをブランкиングするため、短時間だけ電子ビームを偏向させず残りは電子ビームを偏向させるような電圧を静電偏向器14に与え、偏向された電子ビームは開口アーチャ15で除去するようにすることにより、短パルスの電子ビームが得られる。この短パルスの電子ビームを試料面SFに入射させ、試料面上のデバイスを作動状態にして、パターンの電位測定を良好な時間分解能で測定すれば、デバイスの動作解析が行える。

## 【0016】

図2は、上述の構成を有する電子線装置の第一次光学系と第二次光学系の組を試料S上で複数組配置した状態の平面図を示しており、この実施形態では、6組の一次光学系10と二次光学系30とが2行3列に配列されている。実線で描かれた円10aないし10fは第一次光学系の最大外径を示し、一点鎖線で描かれた円30aないし30fは第二次光学系の最大外径を示す。また、本実施形態では、第一次光学系10の開口板13の小孔は3行3列に配列されており、第二次光学系30の開口板32の小孔も同様に3行3列に配列されている。複数の各光学系の組は、各々が互いに干渉しないように、各第二次光学系30の光軸Bが行の並び方向に沿って試料の外側に向かうように配置されている。列の数は、好ましくは3、4列程度であるが、これ以下の2列、或いは4列以上であってもよい。

## 【0017】

次に、図3及び図4を参照して本発明による半導体デバイスの製造方法を説明する。

図3は本発明による半導体デバイスの製造方法の一実施例を示すフローチャートである。この実施例の工程は以下の主工程を含んでいる。

- (1) ウエハを製造するウエハ製造工程（又はウエハを準備するウエハ準備工程）
- (2) 露光に使用するマスクを製造するマスクを製造するマスク製造工程（又はマスクを準備するマスク準備工程）
- (3) ウエハに必要な加工処理を行うウエハプロセッシング工程
- (4) ウエハ上に形成されたチップを一個づつ切り出し、動作可能にならしめるチップ組立工程
- (5) できたチップを検査するチップ検査工程

なお、上記のそれぞれの主工程は更に幾つかのサブ工程からなっている。

## 【0018】

これらの主工程の中で、半導体デバイスの性能に決定的な影響を及ぼすのが(3)のウエハプロセッシング工程である。この工程では、設計された回路パター

ンをウエハ上に順次積層し、メモリーやMPUとして動作するチップを多数形成する。このウエハプロセッシング工程は以下の各工程を含んでいる。

- (1) 絶縁層となる誘電体薄膜や配線部、或いは電極部を形成する金属薄膜等を形成する薄膜形成工程(CVDやスパッタリング等を用いる)
- (2) この薄膜層やウエハ基板を酸化する酸化工程
- (3) 薄膜層やウエハ基板を選択的に加工するためにマスク(レクチル)を用いてレジストパターンを形成するリソグラフィー工程
- (4) レジストパターンに従って薄膜層や基板を加工するエッチング工程(例えばドライエッチング技術を用いる)
- (5) イオン・不純物注入拡散工程
- (6) レジスト剥離工程
- (7) 加工されたウエハを検査する工程

なお、ウエハプロセッシング工程は必要な層数だけ繰り返し行い、設計通り動作する半導体デバイスを製造する。

#### 【0019】

図4は、図3のウエハプロセッシング工程の中核をなすリソグラフィー工程を示すフローチャートである。リソグラフィー工程は以下の各工程を含む。

- (1) 前段の工程で回路パターンが形成されたウエハ上にレジストをコートするレジスト塗布工程
- (2) レジストを露光する工程
- (3) 露光されたレジストを現像してレジストのパターンを得る現像工程
- (4) 現像されたレジストパターンを安定化するためのアニール工程

上記の半導体デバイス製造工程、ウエハプロセッシング工程、及びリソグラフィー工程については、周知のものでありこれ以上の説明を要しないであろう。

上記(7)の検査工程に本発明に係る欠陥検査方法、欠陥検査装置を用いると、微細なパターンを有する半導体デバイスでも、スループット良く検査できるので、全数検査が可能となり、製品の歩留まりの向上、欠陥製品の出荷防止が可能となる。

#### 【0020】

## 【発明の効果】

- 本発明によれば、以下のような効果を奏することが可能である。
- (1) 複数の電子ビームを使うのでスループットが向上する。
  - (2) 複数のE×B分離器を備え、開口板の小孔の像の位置とE×B分離器のそれぞれの位置とを一致させ、かつそれぞれのE×B分離器の電界で偏向される電子ビームの方向が試料面上で見て相互に逆方向となるようにしたことにより、E×B分離器により生じる色収差を補正することが可能となり、電子ビームを細く絞ることが可能となったため、高い検査精度を確保することができる。
  - (3) 第二のE×B分離器の電界に走査電圧を重畠させて電子ビームの偏向動作をさせるようにしたことにより、第二のE×B分離器と静電偏向器とを兼用させることができ、静電対物レンズ21の上部に新たに静電偏向器を設ける必要性がなく、しかもE×B分離器と静電偏向器の両者を最適の位置に配置することができる。それにより、二次電子の検出効率を向上させることと偏向収差を低減することが同時に可能となり、更に、第二次光学系の光路を大幅に短くすることも可能となる。
  - (4) 電子線装置の第一次光学系と第二次光学系の組を試料上で複数組配置したので、一時に複数の試料を検査することが可能となり、スループットが更に向上する。
  - (5) 静電対物レンズ21と試料面SFとの間に同軸状に静電偏向器22を設け、この静電偏向器22に負の電圧を与えることにより、電位コントラストを評価することが可能になる。
  - (6) 電子ビームをブランкиングする機能を設けて静電偏向器14の電圧を制御して短パルスの電子ビームを形成し、試料面上のデバイスを作動状態にして、パターンの電位測定を良好な時間分解能で測定すれば、デバイスの動作解析が可能となる。

## 【図面の簡単な説明】

## 【図1】

本発明による電子線装置の光学系を模式的に示した説明図である。

## 【図2】

本発明による電子線装置の光学系を、2行複数列にウェハ上で並列して配置した状態を示す図である。

【図3】

デバイス製造工程を示すフローチャートである。

【図4】

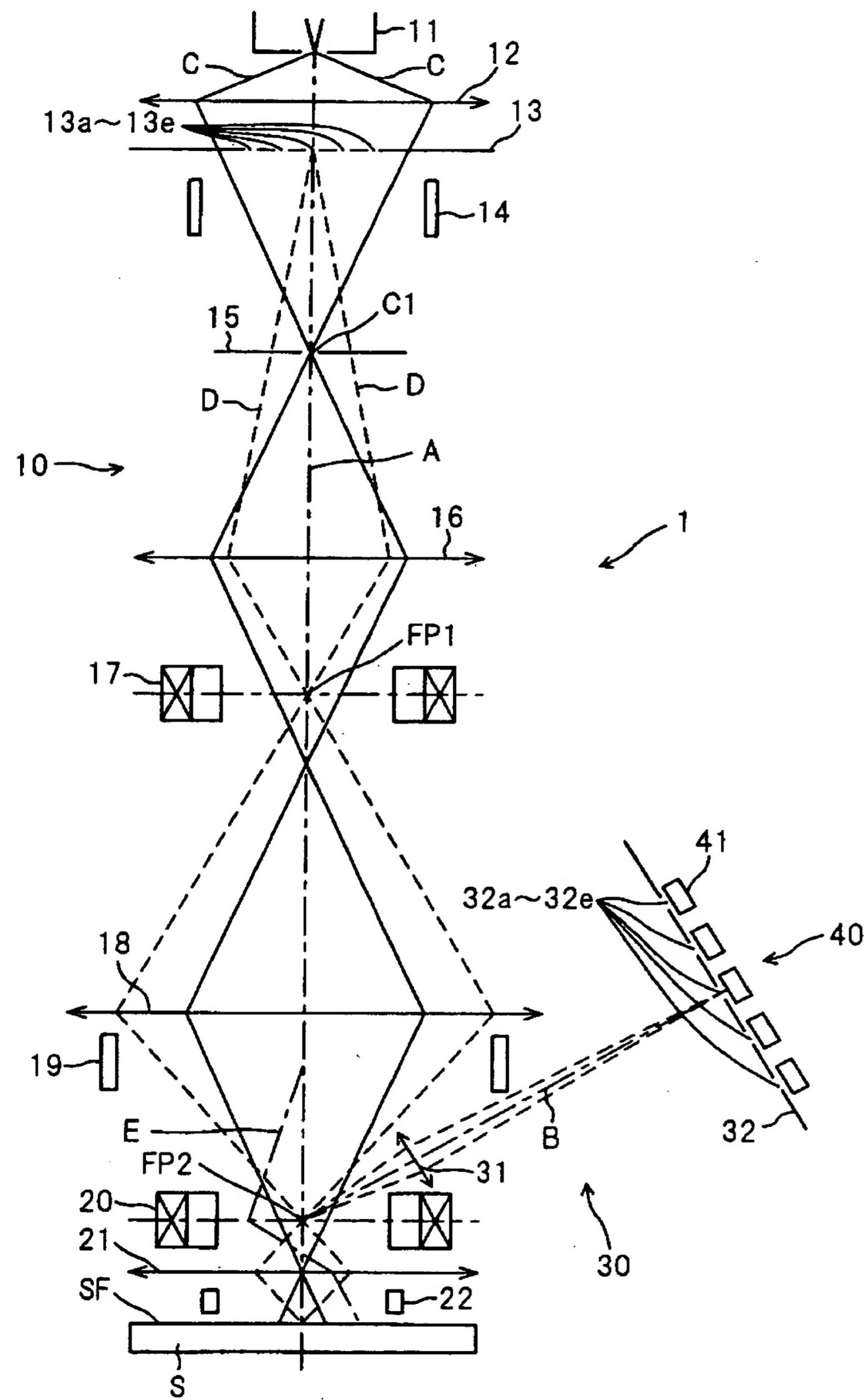
リソグラフィー工程を示すフローチャートである。

【符号の説明】

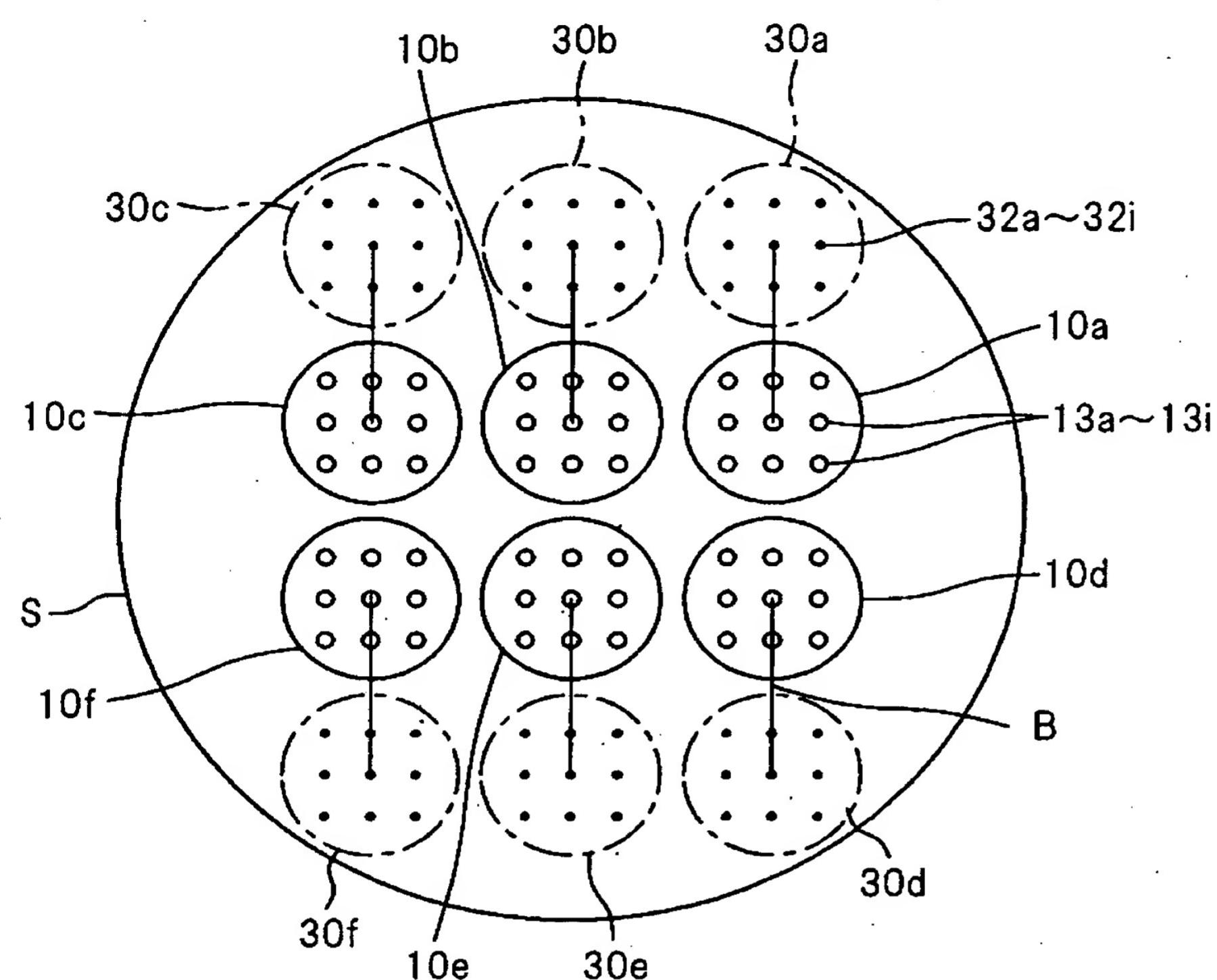
1 : 電子線装置	10 : 第一次光学系
11 : 電子銃	12 : 静電レンズ
13 : 開口板	
14 : 静電偏向器（ブランкиング用）	15 : 開口アパーチャ
16 : 静電中間レンズ	17 : 第一のE×B分離器
18 : 静電中間レンズ	19 : 静電偏向器
20 : 第二のE×B分離器	21 : 静電対物レンズ
22 : 静電偏向器（電位コントラスト測定用）	
30 : 第二次光学系	31 : 静電拡大レンズ
32 : 開口板	40 : 検査装置
41 : 検出器	

【書類名】 図面

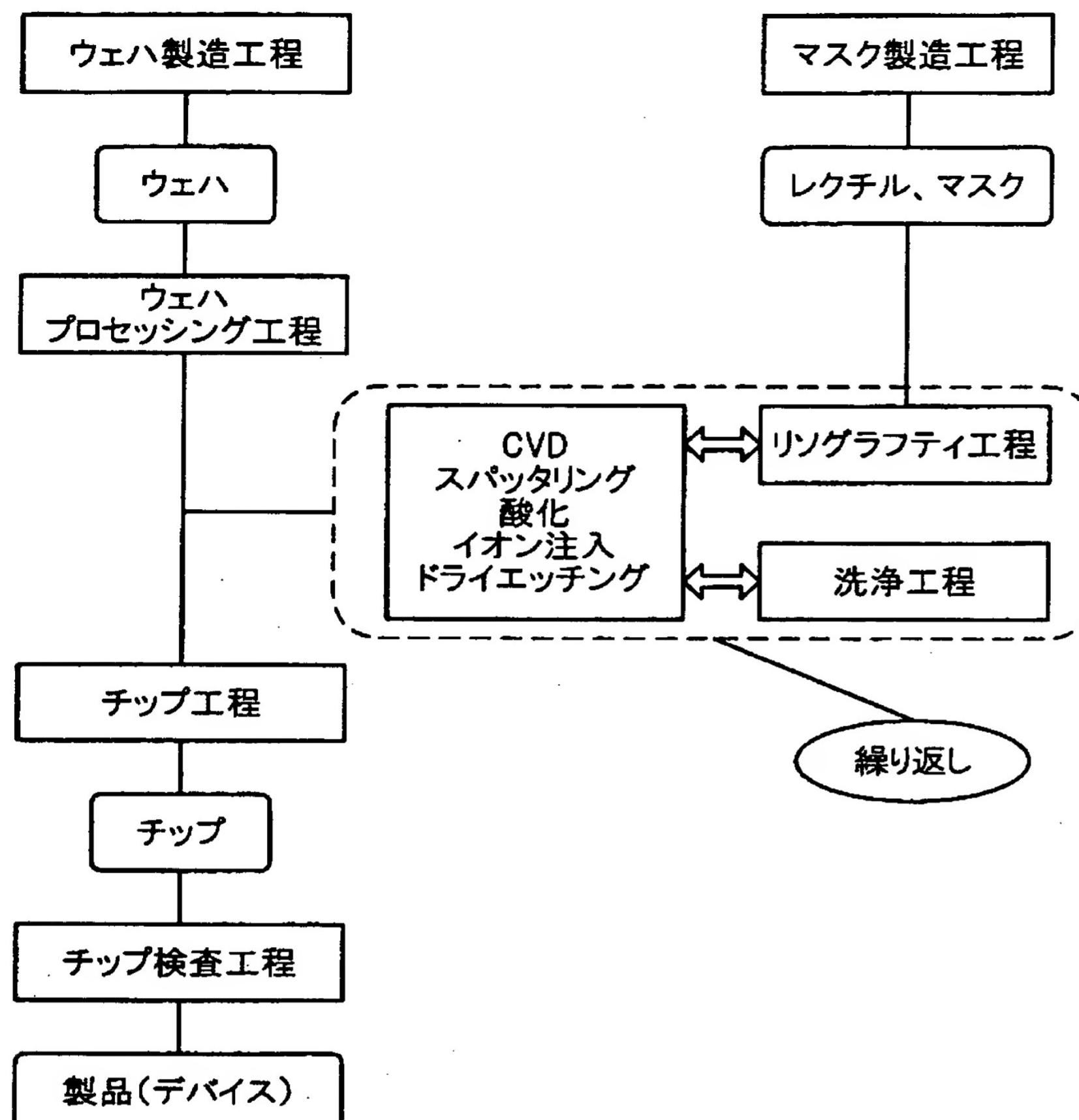
【図1】



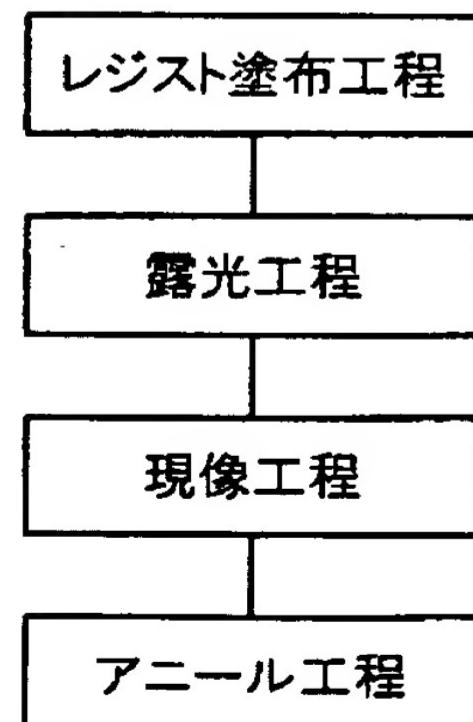
【図2】



【図3】



【図4】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 試料の検査・評価等を高いスループットでしかも高い信頼性で行うことができる具体的な電子線装置を提供する。

【解決手段】 第一次光学系は、電子線を放出する単一の電子銃11、複数の孔を設けた開口板13、複数のレンズ13、16、18及び相互に離隔して配置された複数のE×B分離器17、20を有していて電子銃からの電子線を検査されるべき試料面SF上に照射する。第二次光学系は、試料Sから放出された二次電子をE×B分離器20で第一次光学系から分離し、二次電子検出装置40に入射させる。電子銃からの電子線は開口板13に照射され、開口板の複数個の孔の像が形成される。これらの孔の像の位置は複数のE×B分離器17、20のそれぞれの位置に一致しており、かつそれぞれのE×B分離器17、20の電界で偏向される電子線の方向が試料面上で見て相互に逆方向となっている。

【選択図】 図1

特2000-336091

出願人履歴情報

識別番号 [000004112]

1. 変更年月日 1990年 8月29日

[変更理由] 新規登録

住 所 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号

氏 名 株式会社ニコン

出願人履歴情報

識別番号 [000000239]

1. 変更年月日 1990年 8月31日

[変更理由] 新規登録

住 所 東京都大田区羽田旭町11番1号

氏 名 株式会社荏原製作所